



Soitec étend son portefeuille de substrats innovants au nitrure de gallium (GaN) avec l'acquisition de EpiGaN nv

Cette acquisition permet à Soitec d'accélérer sa pénétration sur les segments de marché en forte croissance de la 5G, de l'électronique de puissance et des capteurs

Bernin (Grenoble), France, le 13 mai 2019 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour avoir signé un accord définitif en vue d'acquiescer EpiGaN, un leader européen de la fourniture de plaques épitaxiées à base de nitrure de gallium (GaN), pour un montant de 30 millions d'Euros en numéraire assorti d'un complément de prix dépendant de l'atteinte d'objectifs. Les substrats à base de nitrure de gallium d'EpiGaN sont principalement destinés aux applications de radiofréquence pour la 5G, à l'électronique de puissance et aux applications pour capteurs, la taille du marché adressable par les technologies basées sur le nitrure de gallium étant estimée à un total compris entre 500 000 et 1 million de plaques par an d'ici cinq ans.

« La technologie basée sur le nitrure de gallium se développe fortement sur les marchés de la radiofréquence et de la puissance. Les substrats épitaxiés en nitrure de gallium constituent un complément stratégique naturel du portefeuille actuel de matériaux innovants de Soitec, » a déclaré Paul Boudre, le Directeur général de Soitec. « L'acquisition d'EpiGaN étend et complète le portefeuille de Soitec au-delà de ses matériaux à base de silicium et permettra la création de nouvelles solutions à valeur ajoutée à la fois pour la radiofréquence appliquée à la 5G et pour les systèmes de puissance. »

Dans le domaine de la mobilité, l'optimisation conjuguée de la performance, du niveau de consommation et du prix est cruciale. L'arrivée de la 5G (Sub-6GHz et mmW) entraîne le développement de nouvelles générations de stations de base par rapport à celles utilisées pour la 4G, ce qui à son tour nécessite de nouveaux amplificateurs de puissance plus efficaces sur le plan énergétique, plus performants, de taille plus réduite et à moindre coût. Soitec va ainsi étendre son offre de substrats innovants destinés aux amplificateurs de puissance, sachant que le nitrure de gallium est aujourd'hui à la pointe dans le domaine du design de produits pour stations de base plus petits, plus légers, plus efficaces et de meilleur rapport coût-efficacité.

« Largement reconnu depuis plusieurs années pour sa grande expertise dans le nitrure de gallium, EpiGaN a développé une technologie qui est à la fois opérationnelle et optimisée pour les applications de réseau à large bande destinées à la 5G, » a déclaré Dr Marianne Germain, co-fondatrice et Directrice générale d'EpiGaN. « Notre technologie présente pour les clients Soitec l'opportunité unique de pouvoir développer rapidement des solutions ciblant de nouveaux marchés en forte croissance, tels que les équipements de radiofréquence, ainsi que les commutateurs de puissance et les capteurs efficaces. »

« La technologie à base de nitrure de gallium développée par EpiGaN ouvre un grand nombre de futures opportunités et nous pensons que Soitec est un excellent partenaire pour continuer à développer pleinement tout le potentiel d'EpiGaN, » a déclaré Katleen Vandermissen, administratrice d'EpiGaN et représentante d'Investment Company of Limburg (LRM), actionnaire de référence d'EpiGaN.

Par ailleurs, l'acquisition d'EpiGaN crée également de nouvelles opportunités de croissance complémentaires pour les produits Power-SOI de Soitec compte tenu de l'utilisation du nitrure de gallium dans le design de transistors de puissance. Le Power-SOI et le nitrure de gallium répondent tous deux au besoin d'intégration de fonctions de haute tension et analogiques dans des circuits intégrés de puissance à la fois intelligents, efficaces sur le plan énergétique et de grande fiabilité pour une utilisation dans les domaines des produits électroniques grand public, des centres de données, de l'automobile et de l'industrie. Une fois intégrée, EpiGaN constituera l'une des Business units de Soitec.

Agenda

Soitec tiendra son Capital Markets Day à Paris le 13 juin 2019.

A propos de Soitec

Soitec (Euronext Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L'entreprise s'appuie sur ses technologies uniques et son expertise dans le domaine des semiconducteurs pour servir les marchés de l'électronique. Avec plus de 3 500 brevets déposés dans le monde, Soitec mène une stratégie d'innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.

Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec

A propos d'EpiGaN

Émanation de l'IMEC (Institut de Micro-Electronique et Composants) fondée en 2010 à Hasselt en Belgique, EpiGaN est un leader européen de la fourniture de solutions technologiques à base

de nitrure de gallium. La technologie développée par EpiGaN est un moteur clé de l'innovation dans les équipements concernant l'alimentation de puissance, les véhicules électriques, la recharge sans fil et les systèmes de puissance RF pour les infrastructures 5G, l'Internet des Objets (IoT) et les systèmes de capteurs intelligents. La société a été intégrée deux fois au cours des trois dernières années dans la prestigieuse liste *Global Cleantech 100*. En 2011, LRM, Capricorn Cleantech Fund et Robert Bosch Venture Capital ont accompagné la société en qualité d'investisseurs, rejoints plus tard par A-Capital et SPFI-FPIM.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.epigan.com

Relations investisseurs Soitec :

Steve Babureck
+33 6 16 38 56 27
+1 858 519 6230
steve.babureck@soitec.com

Contact presse Soitec :

Erin Berard
+33 6 80 36 53 40
erin.berard@soitec.com

#

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 62 762 070,50 euros, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.

#